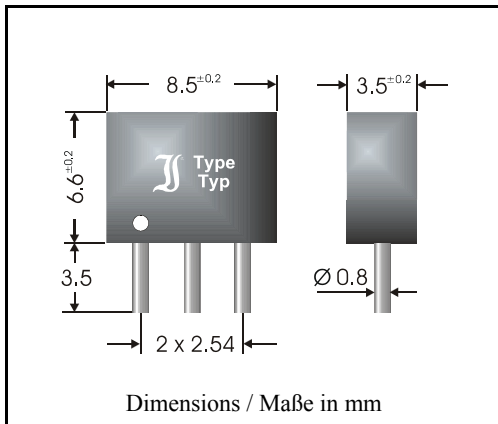
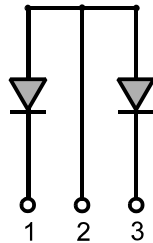
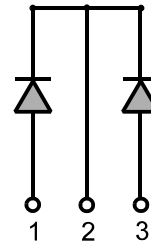


Silicon-Twin Diodes
Center tap
Silizium-Doppeldioden
Mittelpunktschaltung


Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	1.2 W
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	150 V
3 Pin-Plastic case 3 Pin-Kunststoffgehäuse	8.5 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton	see page 22 s. Seite 22



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden



"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAN 208	100	150
DAP 208	100	150

Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1.0 A ¹⁾ 2.0 A ¹⁾
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last, für eine einzelne Diode bei gleichzeitigem Betrieb	$T_U = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1.0 A ¹⁾ 2.0 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	10 A

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	- 50...+150°C

Characteristics			Kennwerte	
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	V_F	< 1.2 V ¹⁾
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 100\text{ V}$	I_R	< 10 µA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 45 K/W ²⁾

¹⁾ Valid for one diode – Gültig für eine Diode

²⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten